



NIEP 國家實驗研究院

台灣半導體研究中心

Taiwan Semiconductor Research Institute

台灣半導體研究中心優秀青年獎學金 (Taiwan Semiconductor Young Talent Fellowship)

關於台灣半導體研究中心優秀青年獎學金

台灣半導體研究中心(以下簡稱本中心)為因應國際半導體產業及研究發展趨勢，配合國家政策需求，並強化與國內大學間實質學術合作，於 113 年起辦理半導體優秀青年甄選，提供「台灣半導體研究中心優秀青年獎學金」，旨在長期培育半導體研究領域所需之重點人才，以維持台灣在高科技產業的競爭優勢。

獎助內容

獲本獎學金者，本中心將視其實際參與培育情形，提供其在學修業期間每人每年獎學金新台幣 24 萬至 60 萬，獎學金為期至多七年(領有本獎學金者，不得重複領取本中心或國研院其他中心之津貼或工作酬金)。

榮譽

■ 博士生

本中心將於 SNDCT 或 VLSICAD 大會頒發「台灣半導體研究中心優秀青年獎」殊榮。

■ 指導教授

獲獎博士生之指導教授得由本中心聘為兼任或合聘研究人員。

申請及審查

■ 資格及名額

一、與財團法人國家實驗研究院簽訂學術合作協議之大學院校在學本國籍或外國籍之全職在學博士生(含已獲入學許可之準博士生，但不包含進修部、在職專班、推廣教育或任何在職形式進修者)，且其學位論文研究主題與半導體領域研究相關者，其中以本中心當年度優先發展之重點研究領域為優先。本中心 114 年度優先發展之重點研究領域如下：

- (一)量子運算元件、製程與電路研發
- (二)矽光子元件、製程與電路研發
- (三)化合物半導體元件、製程與電路研發
- (四)異質整合製程與電路研發
- (五)新興智慧感測與節能應用相關晶片設計
- (六)十六奈米以下晶片設計
- (七)智慧半導體工廠管理與相關技術開發
- (八)電子設計自動化(AI、多重物理輔助設計環境)
- (九)新型通道材料(氧化物與二維材料半導體)元件與製程技術研究
- (十)前瞻材料分析技術

二、114 年第二次甄選，錄取名額至多 10 名。

■ 申請及審查

一、114 年第二次申請時間，自即日起至 114 年 7 月 2 日止。

二、請備妥下列文件電子檔案，以電子郵件寄至「台灣半導體研究中心」主任室許小姐(E-Mail: annahsu@nlar.org.tw)。未依申請規定填寫申請文件或申請文件不全，經限期補正，不能補正或逾期未補正者，恕不受理。

(一)申請表(附件一)

(二)個人簡歷(包含社團活動或課外活動簡述)

(三)大學與研究所歷年成績單(含排名)

(四)博士學位研究計畫書(附件二)

(五)碩士論文成果簡述(直攻博士者免附，或得以其他研究成果替代)

(六)碩士論文電子檔(直攻博士者免附，或得以其他研究成果替代)

(七)指導教授推薦信一封

(八)其他有助於審查資料(會議或期刊論文、得獎紀錄或證書)(附件三)

(九)獲獎資訊、活動影像及個人資料告知事項及授權同意書(附件四)

三、每件申請案將邀請相關領域之專業人士進行第一階段書面審查，書面審查通過者將通知進行第二階段面試。

四、錄取名單將通知獲獎博士生並公告於本中心網頁。

義 務

一、獲獎博士生應至本中心進行學習研究(每週不少於 2 日)。

二、本中心得指派相關領域之研究人員擔任獲獎博士生之論文共同指導，並得要求獲獎博士生共同進行研究專案，並定期報告專案研究進度。

三、獲獎博士生如參與本中心之研究計畫，所發表之研究報告及論文，應註明與本中心之關係。如有涉及智慧財產權，其權利之分配另議。

四、本中心依獲獎博士生所參與研究專案之表現、在校成績等事項每年進行考核。考核結果不佳，研判無法達到人才培育目的，或其他嚴重違反法令或本中心相關規定者，得立即終止其獎學金。

■ 本案聯絡方式如下：

窗 口：許小姐

E-Mail：annahsu@nlar.org.tw

TEL：03-5773693 分機 7742